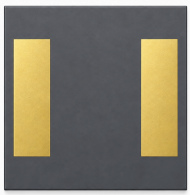
1000 Ω GaAs薄膜抵抗ベアダイ

抵抗値: 1000 Ω (標準値); リニア動作電流: 0.04 A (標準値); 最大許容電流: 0.08 A (最大値). ダイ平面寸法: 0.5 × 0.5 mm.



電気特性 · TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
抵抗素子数	-	-	-	-	1	-
端子数	-	-	-	-	2	-
抵抗値	-	-	1000	-	-	Ω
抵抗値許容差	-	-	±5	-	-	%
リニア動作電流	-	-	0.04	-	-	A

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大許容電流	-	-	-	0.08	A

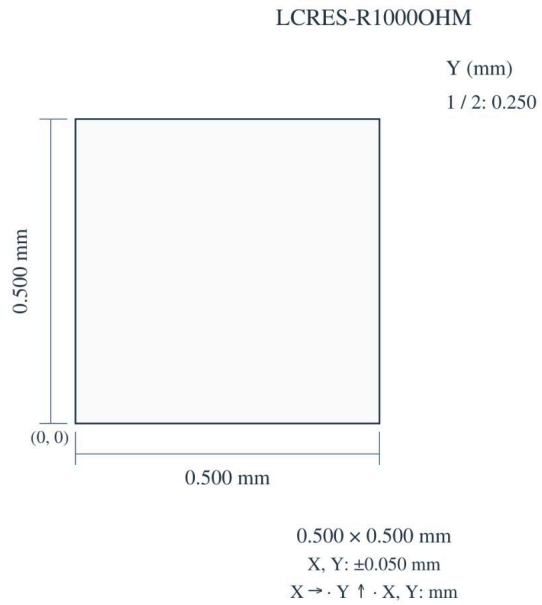
環境仕様

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
保存温度	-	-65	-	150	°C
動作温度	-	-55	-	125	°C

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ平面寸法	0.5 × 0.5	mm

外形寸法図



寸法の単位はすべて mm [in] です。

ボンディングパッド配置

ピン番号	記号	機能	備考
1, 2	IN/OUT	相反入力/出力	-
チップ裏面	GND	接地	RF / DC GND

現在の発行記録 · 1.1 · 2026-10-23. 仕様表の内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.0.

ダイ実装とバイアスの印加順序

ダイ裏面を確実に接地してください。

機械参照図の適用範囲

元資料に基づく mm 単位の寸法参考図です。確認済みの一部情報を示しており、製造やワイヤボンディング用の完全な図面ではありません。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。